

航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材
项目环境影响评价公众参与说明

建设单位：四川铖特新材料科技有限公司

二〇二三年二月

1 概述

随着产业升级和航空航天以及精密设备等领域的高速发展，钪、钼等稀有难熔金属得到越来越广泛的应用。主要应用领域包括：航空航天领域耐高温部件、等离子切割、半导体和电子元器件，以及高端耐腐蚀设备和容器等。

芯片小型化需要工艺和材料的支持。随着芯片从 25 纳米到 13 纳米甚至 9 纳米越做越小，单位面积上的导电材料更为密集，之间也会形成一定干扰。纳米级绝缘材料对于实现芯片小型化至关重要。高纯四氯化钪因其独特的优越性能，可以以喷溅方式形成纳米级的绝缘材料。

金属钼和钪具有较好的抗氧化性能、良好的导热、导电性能和较低的电子逸出功，被用来作为等离子切割用电极中的等离子发射体，通过镶嵌（或其他方法）到铜基体中加工成电极。电极作为等离子切割机割炬中的主要消耗品，其使用寿命的长短直接影响到等离子切割的加工成本和生产效率，电极更换越频繁，其加工成本越高，生产效率相应就低，很多方面影响到电极的使用寿命。随着等离子切割技术的不断发展，对于电极使用寿命的要求越来越高。钪比钼具有更好的性能，其切割能力和使用寿命都数倍于钼电极。钪丝材的质量对提高电极的使用寿命起着至关重要的作用。

二氧化钪(HfO_2)是一种具有宽带隙和高介电常数的陶瓷材料，近来在工业界特别是微电子领域被引起极度的关注，由于它最可能替代目前硅基集成电路的核心器件金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的栅极绝缘层二氧化硅(SiO_2)，以解决目前 MOSFET 中传统 SiO_2/Si 结构的尺寸极限问题。随着金属氧化物半导体(MOS)器件尺寸的缩小，栅极漏电急剧增加，导致器件不能正常工作。为了降低超薄栅介质 MOS 器件的栅极漏电，需采用高介电常数(高 k)栅介质代替 SiO_2 。钪(Hf)系氧化物和氮氧化物由于具有高的 k 值，好的热稳定性，成为当前高 k 栅介质的研究热点。当 CMOS 器件小于 $0.1\mu\text{m}$ 时，由于栅极漏电流所带来的功率消耗以及高温问题亟待解决，高介电薄膜技术成为解决这一问题的关键。 HfO_2 溅射薄膜由于具有高介电常数、高介电强度、低介电损耗、低漏电流及良好的电容-电压特性、良好的稳定性以及能与基体硅的牢固结合等优点，被认为是最有前途新型绝缘介质膜之一。此外，氧化钪从紫外到红外区间($0.22\sim 12\mu\text{m}$)具有高的光学透过率，因此在光学膜领域也有广阔的应用前景。

靶材是 HfO₂ 溅射薄膜材料的源极，研制高纯、高致密度、高可靠性的磁控溅射靶材在 HfO₂ 镀膜工艺中非常重要。

同时锆铪在多种酸、碱、盐介质中具优异的耐腐蚀性能，尤其是在醋酸、盐酸、高温硫酸中耐腐蚀性能皆优于常用金属，在不锈钢、镍合金、钛合金不能胜任的条件下，往往使用锆作为接触腐蚀介质的热交换器、冷凝器、反应塔、泵、阀等结构材料。特别是醋酸生产中，反应塔、热交换器等都必须使用锆制设备。

为了抢占市场，适应市场需求和经济发展要求，提高企业市场竞争力，四川铽特新材料科技有限公司拟在乐山市五通桥区投资建设“航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材项目”，目前该项目已在五通桥区发展和改革局备案（备案号：川投资备[2207-211112-04-01-474666]FGQB-0069 号），主要建设内容为：项目占地约 30 亩，新建晶条生产车间、铪丝车间、分离和提纯车间等，购置设备 180 余台套，采用国内先进的工艺技术，项目建成后，生产规模为年产 20 吨高纯铪晶条、50 吨芯片电子先材料以及相应的高纯产品。

依据《环境影响评价公众参与办法》，应当征求建设项目所在地单位和居民的意见，以公开建设项目的环境信息和强化社会监督，并规定了公众参与的程序和方法。因此，本项目环评期间，进行了广泛的公众参与调查。

我公司正式委托乐山市四维环保科技有限公司开展本项目的环评影响评价工作，期间同步开展了项目公众参与调查工作，相关内容见下表：

表 1-1 公众参与内容及过程

公示方式	时间	地点	内容
网络公示	2022 年 8 月 17 日	乐山市五通桥区人民政府网	航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材项目环境影响评价第一次公示
	2022 年 11 月 11 日 -2022 年 11 月 24 日	乐山市五通桥区人民政府网	航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材项目环境影响评价第二次公示
	2022 年 12 月 26 日	乐山市五通桥区人民政府网	航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材项目环境影响评价第三次公示
报纸公示	2022 年 11 月 16 日	四川科技报	航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材项目环境影响评价公众参与公示
	2022 年 11 月 18 日	四川科技报	航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材项目环境影响评价公众参与公示
信息张贴公告	2022 年 11 月 11 日 -2022 年 11 月 24 日	桥沟镇公开栏	航空航天芯片用电子新材料超高纯铪材项目环境影响评价第二次公示

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

首次环境影响评价公开内容为：建设项目的名称及概要、建设单位名称及联系方式、环评机构的名称及联系方式、环评工作程序及主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等。公开日期为2020年9月29日。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本项目于2022年8月17日在乐山市五通桥区人民政府网站（<http://www.wtq.gov.cn/ztq/zjdcwtq/zjdccontent.shtml?id=ff808081823d51620182a9a9806f003a>）上进行了第一次信息公示，公开内容见下图：



图 2-1 项目第一次公示网络公开截图

2.2.2 其他

本项目首次环境影响评价信息公开的同时公示了公众意见调查表的网络链接。

2.3 公众意见情况

在首次环境影响评价信息公示期间未接到有关来电来访对本项目环境保护提出建议和意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

本项目征求意见稿公示内容包括：环境影响报告书（征求意见稿）全文及网络链接、查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表及网络链接、公众提出意见的起止时间等。

公示时限为 10 个工作日，网络公示时间为 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 24 日；报纸刊登时间为 2022 年 11 月 16 日与 2022 年 11 月 18 日；现场张贴公示时间为 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 24 日。

因此，本项目征求意见稿公示是符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）相关要求的。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

环境影响报告书（征求意见稿）编制完成后，于 2022 年 11 月 11 日乐山市五通桥区人民政府网站（<http://www.wtq.gov.cn/wtqq/zjdcwtq/zjdccontent.shtml?id=ff808081845f9b960184607a307e0000>）上进行了第二次信息公示，公示内容见下图：



图 3-1 第二次网上公示截图

3.2.2 报纸

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，项目同时采取报纸登报公开方式，本项目于2022年11月16日和2022年11月28日先后两次将公示信息刊登在四川科技报，公示内容见下图：



图 3-2 征求意见稿第一次登报公示照片



图 3-3 征求意见稿第二次登报公示照片

3.2.3 张贴

本项目建设地点位于乐山市五通桥区会云村，本项目在公示期间，同时采取了张贴公告公示，公告张贴在会云村公示栏上，张贴时间为2022年11月11日至11月24日，此次张贴公示区域选取符合《环境影响评价公众参与办法》的要求，张贴照片见下图：



图 3-4 现场公示

3.2.4 其他

本项目除网络、报纸、张贴方式外未采取其他方式对征求意见稿进行公示。

3.3 查阅情况

在航空航天芯片用电子新材料超高纯铅材项目环境影响公众参与公示期间，无人到现场查阅征求意见稿文本。

3.4 公众提出意见情况

本项目环境影响评价公众参与第二次公示（征求意见稿）期间，通过网络公示、张贴公示反馈意见。未收到相关的公众意见反馈。

4 报批前公示

4.1 公开内容及日期

第三次环境影响评价公开内容为：环境影响报告书（公示本）、公参说明。公开日期为2022年12月26日。

4.2 公开方式

4.2.1 网络

本项目于2022年12月26日在乐山市五通桥区人民政府网站（<http://www.wtq.gov.cn/wtqq/zjdcwtq/zjdccontent.shtml?id=ff8080818532488f01854c16b2bc0005>）对《航空航天芯片用电子新材料超高纯铅材项目环境影响报告书》及公众参与说明进行了报批前公开，公开内容见下图：



图 4-1 项目第三次公示网络公开截图

5 其他公众参与情况

本项目未采取其他深度公众参与。

6 其他

环境影响评价公众意见表依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，不纳入本项目环境影响评价公众参与说明的附件，但应存档备查。

本项目未收到公众反馈的环境影响评价公众意见表。

7 诚信承诺

本公司诚信承诺如下：

诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在航空航天芯片用电子新材料超高纯铅材项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《航空航天芯片用电子新材料超高纯铅材项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由四川铖特新材料科技有限公司承担全部责任。

承诺单位：四川铖特新材料科技有限公司

承诺时间：2023年1月16日